# 電気電子基礎学「電子デバイス」

#### 「ナノテクノロジーが拓く未来のコンピューター」2

#### 東京工業大学

### 大学院理工学研究科電子物理工学専攻 量子ナノエレクトロニクス研究センター 小田 俊理



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY







量子ドット

ナノテクノロジーでできること

2000年 米国の国家ナノテクノロジーイニシアティブ (NNI) でクリントン前大統領が演説 (カリフォルニア工科大学)

- 鉄よりも10倍つよく、しかもずっと軽い材料を開発して全ての乗り物を軽くして燃費を下げる。
  - 国会図書館の情報を角砂糖の大きさのメモリに収容する。
- ガンを細胞数個程度の段階で検出してそこを狙い撃ちして遺伝
  子や薬物を送り込む。

●太陽電池のエネルギー効率を2倍にする。

1959年 ファインマン

"There's Plenty of Room at the Bottom"

「コンピューターのビットを原子一個にすることに何の物理的障害もない」

ナノ構造の作り方

#### トップダウン法

マクロの構造からスタートして微細加工を行う。 リソグラフィ技術

● ボトムアップ法

ミクロの原子1個1個を積み上げていく。

STM(走查型電子顕微鏡)

SAM(自己組織化分子)

結晶成長

トップダウン法:リソグラフィ技術





トランジスタ コンデンサー 抵抗

金属配線

シリコン基板

拡散層



QUERC Quantum Nanoelectronics Research Center

多結晶シリコン

酸化膜

Tokyo Institute of Technology



#### 電子ビーム露光による3次元ナノ構造構築支援 東工大







ボトムアップ法:STM



#### The Nobel Prize in Physics 1986

"for his fundamental work in electron optics, and for the design of the first electron microscope"

"for their design of the scanning tunneling microscope"



Ernst Ruska 1/2 of the prize Federal Republic of Germany Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft Berlin, Federal

Republic of Germany

b. 1906

d. 1988



Gerd Binnig 1/4 of the prize Federal Republic of Germany

IBM Zurich Research Laboratory R緒chlikon, Switzerland

.

b. 1947

earch Cente



Heinrich Rohrer 1/4 of the prize Switzerland

IBM Zurich Research Laboratory R緒chlikon, Switzerland

b. 1933

Shunri Oda

уgy



#### STMで並べたニッケル板上のキセノン原子







**CURREC** Tokyo Institute of Technology





#### STMで並べた銅板 上の鉄原子





#### **Quantum Corrals**

#### STMで並べた銅板上の48個の鉄原子







Tokyo Institute of Technology

### 量子効果1:トンネル効果

ΤΟΚΥΟ ΤΕΕΗ

Pursuing Excellence





(E < V<sub>0</sub>)の粒子は障壁を超

えることができない。

物質波



(E < V<sub>0</sub>) の粒子(電子)は障 壁を透過できる。



「電子物性概論 –量子論の基礎–」阿部正紀著.

Shunri Oda

#### トンネル効果の例1:MOSFETのゲートリーク電流



## <u>走査トンネル顕微鏡(STM)</u>

プローブと試料表面の間隔により、ト ンネル電流は大きく変わる。 トンネル電流が一定になるように、プ ローブ位置を制御する。 プローブ位置の変化を測定する。

ΓΟΚ

TECH

Pursuing Excellence



原子レベルの精度で表面原子構造が 判る。

Shunri Oda

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

'**≪ d**→

Probe (Metal)

х

Fermi

Level

トンネルダイオード(江崎ダイオード)

#### 高濃度に不純物ドーピングされたpn接合ダイオードの電流電圧特性

▶負性抵抗現象をトンネル効果で説明



This figure is from "SEMICONDUCTOR DEVICES: Physics and Technology, 2<sup>nd</sup> Edition" by S. M. Sze.

Static current-voltage characteristics of a typical tunnel diode.  $I_p$  and  $V_p$  are the peak current and peak voltage, respectively.  $I_V$  and  $V_V$  are the valley current and valley voltage, respectively. The upper figures show the band diagrams of the device at different bias voltages.



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

## 量子効果2:電子閉じこめ効果

電子状態密度 のエネルギー 依存性





### 将来のトランジスター:シリコンナノワイヤ



• 直径5nmのナノワイヤでトランジスター動作を実証

ΤΟΚΥΟ ΤΕCΗ

Pursuing Excellence

Shunri Oda

### 将来のトランジスター:カーボンナノチューブ



## シリコン量子ドット



10nm

ΤΟΚΥΟ ΤΕCH

Pursuing Excellence



Shunri Oda





NEMSデバイス

発光デバイス

### 将来のトランジスター:単電子トランジスター



将来の量子コンピュータ



23

### Si ナノドット不揮発性メモリー



1. 電源を切っても消えない半導体メモリー

ΤΟΚ

TECH

Pursuina Excellence

2. 将来はテラビットの大容量メモリー

### Si量子ドットからの発光



## Si量子ドット発光素子



Cheong, Oda, CLEO2006

ナノ結晶Si量子ドットダイオードから可視
 光発光を観測

ΤΟΚ

Pursuing Excellence



Shunri Oda

まとめ

- ナノテクノロジーによる新しい世界
- 量子効果が顕著になる
- 量子ワイヤ、量子ドットを利用する新しいデバ
  イスが世界を変える